

## Сведение об оппоненте

по диссертационной работе Алидодова Тутишо Мералишоевича на тему «Исследование внутренних напряжений лазерных диодов на основе двойных гетереоструктур GaInPAs/InP по их излучательным характеристикам», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния».

Фамилия Имя Отчество оппонента	<b>КАРИМОВ ХАСАН САНГИНОВИЧ</b>
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.07 - Физика конденсированного состояния,
Ученая степень и отрасль науки	доктор физико-математических наук, по специальности 01.04.07 - Физика конденсированного состояния
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Государственная научная учреждения «Центр инновационного развития науки и новых технологий» при Национальной академии наук Таджикистана;
Занимаемая должность	Ведущий научный сотрудник отдела новых технологий
Почтовый индекс, адрес	Республика Таджикистан, 720025 г.Душанбе, Проспект Рудаки 33
Телефон	<b>Телефон:</b> +992 919033479
Адрес электронной почты	<a href="mailto:khasansangink@gmail.com">khasansangink@gmail.com</a>
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1.Х.С.Каримов, Х.М.Ахмедов, К.Кабутов и др. Влияние температуры на электрические свойства электрохимического элемента на основе n-InP. Изв. АН РТ. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, № 1, 2013, с. 84-89.</p> <p>2.Х.С.Каримов, Х.М.Ахмедов, Н.Ахмед, А.Фарук, З.Ю.Резви. Фотоэлектрический элемент на основе объемной гетероструктуры органических полупроводников фталоцианина меди и фталоцианина без металла. Докл. АН РТ, т.57, № 7, 2014, с. 567-572.</p> <p>3.S. Karimov, M.M. Ahmed, F. Noshin, M. Saleem, M.M. Tahir, S.A. Moiz, Kh.M., Akhmedov, M.S. Zahid, S.Z. Abbas, A. Rashid, Nickel phthalocyanine based organic photo transistor: effect of semiconductor film thickness", European Physical Journal: Applied Physics", (2015) 72: 20202 DOI:10.1051/epjap/20151503, pp.20202-p1-p7.</p> <p>4.Х.С.Каримов, М.М.Рехман, Х.М.Ахмедов, С.З.Аббас. Энергонезависимый элемент памяти поверхностного типа на основе гетероструктуры орга-</p>

нических полупроводников CuPc- H2 Доклады АН РТ, №5, т.58, 2015, с.500-503.

5.S. Karimov, M.M. Ahmed, F. Noshin, M. Saleem, M.M. Tahir, S.A. Moiz, Kh.M. Akhmedov, M.S. Zahid, S.Z. Abbas, A. Rashid. Nickel phthalocyanine based organic photo transistor: effect of semiconductor film thickness. European Physical Journal: Applied Physics (2015) 72:20202 DOI:10.1051/epjap/20151503, pp.20202-p1-p7.

6.Муртаза М., Каримов Х.С., Ахмедов Х.М. Влияние влажности на подвижность носителей заряда в органическом полупроводнике РТСДИ-С – Изв. АН РТ. Отд. физ.-мат., хим., геол. и техн. наук, 2016, № 3, с. 62-66.

7.Fatima N., Ahmed M.M., Karimov Kh.S., Akhmedov Kh.M. Humidity effect on organic semiconductor NiPc films deposited at different gravity conditions. – 14-th International Symposium on Advanced Materials IOP Conf.Series. Materials Science and Engineering 146, 2016, 012035, pp. 1-8.

«Верно»

Ученый секретарь Центра

Начальник ОК Центра



Бухоризода Р.А

Сангинова С.Б